

弊社では、お客様からのご要望に合わせて熱処理を行っております。SiCのデバイス作製に適した高温イオン注入、キャップ膜成膜や高温アニール処理といった一連の処理を弊社で行うことが可能です。

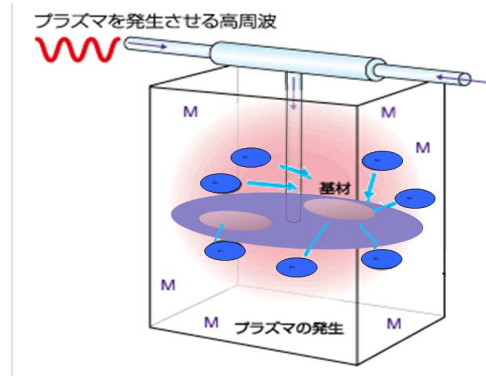
## 高温イオン注入

600℃までの高温注入  
小片～6inchサイズに対応  
注入ダメージ軽減に有効



## キャップ膜成膜

C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>を反応させ、DLC膜を成膜  
小片～6inchサイズに対応  
アニール処理による表面荒れの緩和に有効



## 高温アニール処理

最大1800℃のアニール処理  
小片～6inchサイズに対応  
様々な化合物半導体へ対応

